14482, Москва, Зеленоград, а/я 167, ЗАО «ЭПЛ». Тел./факс (495) 229-75-27, тел.(495) 229-75-28. E-mail: epl@epl.ru, http://www.epl.ru

КТ8283 (А,Б,В) АДКБ.432140. ТУ

Мощный PNP кремниевый транзистор

КТД8283 - биполярный эпитаксиально-планарный транзистор.

Прибор предназначен

для работы в схемах управления двигателями, низковольтовых DC/DC и DC/AC преобразователях, источниках бесперебойного питания и источниках лазерной накачки.

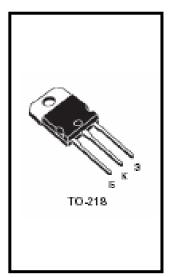
Отличительные особенности

комплиментарная пара (к КТ8282) на токи коллектора 25-60А с низким напряжением насыщения.

Аналог: нет.

Выпускается

в пластмассовом корпусе ТО-218 и в бескорпусном исполнении - кристалле для использования в составе гибридных схем.



Предельно-допустимые режимы эксплуатации.

Папаметры	Обозначение	KT8283			Ед.
Параметры		A	Б	В	измер.
Напряжение коллектор-база	Uкбо	80	100	120	В
Напряжение коллектор-эмиттер	Uкэo	80	100	120	В
Напряжение эмиттер-база	Uэбo	5	5	5	В
Ток коллектора постоянный	lκ	60	60	60	A
Ток коллектора импульсный	Іки	80	80	80	A
Ток базы постоянный	lб	5	5	5	A
Рассеиваемая мощность коллектора	Рк max	120	120	120	Вт
Температура перехода	Tj	-65÷+150	-65÷+150	-65÷+150	°C

Основные электрические параметры (Ткорп.=25 °C).

Параметры	Обозна чение	Норма	Режим	Групп а	Ед. изм
Обратный ток коллектор-эмиттер	Ікэо	≤150	Uкэ=60B, R _Б =∞	Α	
			Uкэ=80B, R _Б =∞	Б	мкА
			Uкэ=100B, R _Б =∞	В	
Обратный ток коллектор-база	Ікбо	≤100	Uкб= Uкэо _{ГР} +20В	А,Б,В	мкА
Напряжение коллектор-эмиттер граничное	Uкэо гР	≥80		Α	
		≥100	Iк=100мA	Б	В
		≥120		В	
Обратный ток эмиттер-база	Іэбо	≤20	Uэб=5В	А,Б,В	мА
Напряжение насыщения коллектор- эмиттер	Окэ.нас	≤0,8	Iк=30A, Iб=50мA	А,Б,В	В
Напряжение насыщения база -эмиттер		≤2,5	Iк=30A, Iб=50мA	А,Б,В	В
Статический коэффициент передачи тока	h ₂₁₉	≥100	Iк=50, Uкэ=5B	А,Б,В	-